

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
PUBLIC RELATIONS DIVISION
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8310 Japon

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

n° 3323

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.

Demandes de renseignements des clients

Demandes de renseignements des médias

Semiconductor & Device Marketing Div.B
Mitsubishi Electric Corporation

Public Relations Division
Mitsubishi Electric Corporation
prd.news@nk.MitsubishiElectric.co.jp

www.MitsubishiElectric.com/semiconductors/

www.MitsubishiElectric.com/news/

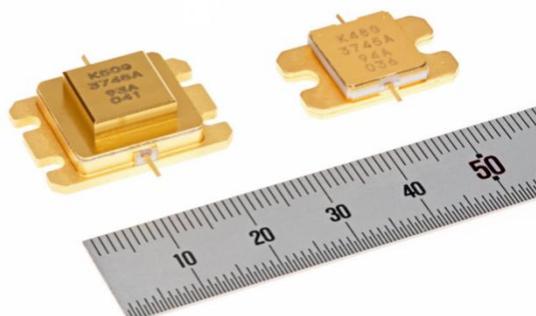
Mitsubishi Electric étend sa gamme de transistors à haute mobilité d'électrons à bande Ku (GaN-HEMT)

Les nouveaux modèles prendront en charge les communications multi-porteuses, augmenteront la capacité de transmission des données et réduiront la taille des stations terrestres de télécommunication par satellite

TOKYO, 12 décembre 2019 – [Mitsubishi Electric Corporation](http://www.MitsubishiElectric.com) (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui l'élargissement de sa gamme de transistors à haute mobilité d'électrons au nitrure de gallium (GaN-HEMT) pour les stations terrestres de télécommunication par satellite (SATCOM) avec l'ajout de nouveaux transistors GaN-HEMT à bande Ku (12-18 GHz) de 70 W et 100 W adaptés aux applications multi-porteuses. Le modèle GaN-HEMT de 70 W permet d'obtenir une faible distorsion d'intermodulation de troisième ordre (IMD3)* avec une large fréquence de décalage** de 400 MHz, soit le plus haut niveau du secteur. Le modèle GaN-HEMT de 100 W dispose quant à lui d'une puissance de sortie inégalée, d'une faible IMD3 et d'une fréquence de décalage allant jusqu'à 200 MHz. Mitsubishi Electric enverra des échantillons de ces deux modèles à compter du 15 janvier.

* Mesure des performances de distorsion d'un amplificateur dans le cas de signaux à deux tonalités

** Différence de fréquence entre des signaux à deux tonalités lors de mesures pour l'IMD3



GaN HEMT pour stations terrestres de télécommunication par satellite à bande Ku
Gauche : MGFK50G3745A (100 W) Droite : MGFK48G3745A (70 W)

Les communications par satellite à bande Ku et la collecte d'informations par satellite (SNG) sont de plus en plus nécessaires pour prendre en charge les communications en cas de catastrophes naturelles et dans les zones rurales où l'installation d'un réseau câblé est difficile. En outre, les communications grande capacité et haut débit ont fait augmenter les besoins en matière de communications multi-porteuses et monoporteuses par satellite. Les nouveaux transistors GaN-HEMT de Mitsubishi Electric devraient accélérer la construction de stations terrestres plus petites, et ainsi permettre des communications à plus haut débit et à plus grande capacité pour répondre à divers besoins.

Planning des ventes

Produit	Application	Modèle	Résumé			Livraison
			Fréquence	Puissance de sortie saturée	Fréquence de décalage	
Transistors GaN-HEMT à bande Ku	Stations terrestres de télécommunication par satellite	MGFK48G3745A	13,75 à 14,5 GHz	48,3 dBm (70 W)	Jusqu'à 400 MHz	15 janvier 2020
		MGFK50G3745A		50,0 dBm (100 W)	Jusqu'à 200 MHz	

Caractéristiques du produit

1) Fréquence de décalage inégalée jusqu'à 400 MHz pour les communications grande capacité par satellite

- Le modèle MGFK48G3745A utilise un nouveau circuit d'impédance pour fournir une large fréquence de décalage, 80 fois supérieure à celle des modèles actuels, ainsi qu'une faible IMD3 avec une large fréquence de décalage allant jusqu'à 400 MHz, pour des communications par satellite haut débit et grande capacité, y compris pour les communications multi-porteuses.

2) Puissance de sortie jusqu'à 100 W qui contribue à réduire la taille des stations terrestres de télécommunication par satellite

- Le modèle MGFK50G3745A utilise des circuits d'impédance de transistors optimisés pour fournir une puissance de sortie maximale de 100 W et une faible IMD3. Cela permet de réduire la taille des stations terrestres de télécommunication par satellite en minimisant les composants embarqués.

Gamme améliorée et spécifications principales (nouveaux modèles en caractères gras)

Modèle	MGFG5H1503	MGFK48G3745	MGFK48G3745A	MGFK50G3745	MGFK50G3745A
Fréquence	13,75 GHz–14,5 GHz				
Puissance de sortie saturée	43 dBm (20 W)	48,3 dBm (70 W)	48,3 dBm (70 W)	50,0 dBm (100 W)	50,0 dBm (100 W)
Gain linéaire	24 dB	12 dB	11 dB	10 dB	10 dB
Fréquence de décalage @IMD3=-25 dBc	Max. 5 MHz	Max. 5 MHz	Max. 400 MHz	Max. 5 MHz	Max. 200 MHz

Sensibilisation à l'environnement

Ces produits sont conformes aux directives européennes 2011/65/UE et (UE) 2015/863 relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS).

Remarque : le développement de ces produits a été partiellement pris en charge par l'agence japonaise New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO, Organisation pour le développement des énergies nouvelles et des technologies industrielles).

###

À propos de Mitsubishi Electric Corporation

Depuis près de 100 ans, Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) propose des produits fiables et de haute qualité. Ce leader international est reconnu pour la fabrication, le marketing et la vente d'équipements électriques et électroniques utilisés dans les domaines suivants : le traitement et la communication de l'information, le développement spatial et les communications par satellite, l'électronique grand public, la technologie industrielle, l'énergie, les transports et l'équipement dans le bâtiment. En se conformant à l'esprit de sa devise « Changes for the Better » et de son engagement environnemental « Eco Changes », Mitsubishi Electric s'efforce d'être une entreprise pionnière et propre en plaçant la technologie au service de la société. L'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 4 519,9 milliards de yens (40,7 milliards de dollars US*) au cours du dernier exercice qui a pris fin le 31 mars 2019. Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.MitsubishiElectric.com

* À un taux de change de 111 yens pour 1 dollar US, taux indiqué par le Tokyo Foreign Exchange Market le 31 mars 2019